PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-113812

(43)Date of publication of application: 16.04.2002

(51)Int.CI.

B32B 15/08 B32B 27/34 H05K 3/00 H05K 3/38 H05K 3/46

(21)Application number: 2001-037128

(71)Applicant: KANEGAFUCHI CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

14.02.2001

(72)Inventor: HARA MASAYUKI

ITO TAKU

NOJIRI HITOSHI

NISHINAKA MASARU

(30)Priority

Priority number: 2000034853

Priority date: 14.02.2000

Priority country: JP

2000235130

03.08.2000

JP

(54) LAMINATE OF POLYIMIDE AND CONDUCTOR LAYER AND MULTILAYER INTERCONNECTION BOARD USING THE SAME AS WELL AS ITS MANUFACTURING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a laminate having excellent adhesive properties between a conductor and a polyimide film without using physical surface roughing and an adhesive metal layer. SOLUTION: The laminate of a polyimide obtained by directly forming at least one conductor layer on the surface of a thermoplastic polyimide and a conductor layer is pressurized and heat treated, heat fusion bonded to strengthen an adhesive strength of the polyimide and the conductor layer.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-113812 (P2002-113812A)

(43)公開日 平成14年4月16日(2002.4.16)

(51) Int.Cl.7		說別記号	FΙ			テーマコート*(参考)	
B 3 2 B	15/08		B32B 1	5/08		R	4F100
						J	5 E 3 4 3
	27/34	•	2	27/34			5 E 3 4 6
H05K	3/00		H05K	3/00		R	·
	3/38			3/38		D	
		審查請求	未請求 請求	質の数16 OL	(全 9	頁)	最終頁に続く
(21)出願番り		特顧2001-37128(P2001-37128)	(71)出顧人	000000941			
				鐘淵化学工業	株式会社	Ł	
(22)出願日		平成13年2月14日(2001.2.14)		大阪府大阪市	i北区中 之	2島3	丁目2番4号
			(72)発明者	原 昌之			
(31)優先権主張番号		特顧2000-34853 (P2000-34853)		神奈川県横海	市育菜区	有菜	台2-28-1-
(32)優先日		平成12年2月14日(2000.2.14)		A104			
(33)優先権主張国		日本 (JP)	(72)発明者	伊藤 卓			
(31)優先権主張番号		特顧2000-235130(P2000-235130)	滋賀県大津市仰木の里4丁目7-15		目7-15		
(32)優先日		平成12年8月3日(2000.8.3)	(72)発明者	野尻 仁志			
(33)優先権主張国		日本 (JP)	溢賀県大津市比叡辻2-1-2-135		-2 - 135		
			(74)代理人	100105647			
		•		弁理士 小栗	1 昌平	例	4名)
							最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ポリイミドと導体層の積層体およびそれを用いてなる多層配線板ならびにその製造方法

(57)【要約】

【課題】 物理的表面粗化及び接着金属層を用いずに導体とポリイミドフィルム間の密着強度の優れた積層物を得る。

【解決手段】 熱可塑性ポリイミドの表面に少なくとも 1層の導体層を直接形成して得られるポリイミドと導体 層の積層体を、加圧及び加熱処理して熱融着せしめ熱可 塑性ポリイミドと導体層との密着強度を強化する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 熱可塑性ポリイミドの表面に少なくとも 1層の導体層を直接形成し、加熱処理して該ポリイミド の表面に該導体層を熱融着せしめ、熱可塑性ポリイミド と導体層との密着強度を強化することを特徴とするポリ イミドと導体層の積層体の製造方法。

【請求項2】 板状材料の片面または両面に熱可塑性ボ リイミドに対応するポリアミド酸を流延または塗布した 後、該ポリアミド酸をイミド化して熱可塑性ポリイミド の表面を有する積層体を得た後、該熱可塑性ポリイミド 10 の表面に少なくとも1層の導体層を直接形成して得られ る積層体を、加熱処理して熱融着せしめ熱可塑性ポリイ ミドと導体層との密着強度を強化することを特徴とする 積層体の製造方法。

【請求項3】 熱可塑性ボリイミドのフィルムを板状材 料の片面又は両面に貼り合わせて、熱可塑性ポリイミド の表面を有するボリイミド積層体を得た後、該熱可塑性 ポリイミドの表面に少なくとも1層の導体層を直接形成 して得られるポリイミドと導体層の積層体を、加熱処理 して熱融着せしめ熱可塑性ポリイミドと導体層との密着 20 強度を強化することを特徴とする積層体の製造方法。

【請求項4】 板状材料が、非熱可塑性ポリイミドフィ ルムである請求項2または3に記載の積層体の製造方 法。

【請求項5】 導体層の厚さが0.01~5µmである 請求項1から4のいずれか一項に記載の製造方法。

【請求項6】 加熱処理温度が50℃以上である請求項 1から5のいずれか一項に記載のポリイミドと導体層の 積層体の製造方法。

【請求項7】 加熱処理温度が熱可塑性ポリイミドのガ ラス転移温度より30℃以上高い温度である請求項1か **ら6のいずれか一項に記載の製造方法。**

【請求項8】 加熱処理して熱融着せしめる際に加圧す ることを特徴とする請求項1から7のいずれか一項に記 載の製造方法。

【請求項9】 加圧時の圧力が、1MPa以上であると とを特徴とする請求項8に記載の積層体の製造方法。

【請求項10】 熱可塑性ポリイミドの表面に少なくと も1層の導体層を直接形成する方法が乾式メッキ法であ ることを特徴とする請求項1から9のいずれか一項に記 40 載の製造方法。

【請求項11】 熱可塑性ポリイミドの表面に少なくと も1層の導体層を直接形成する方法における乾式メッキ 法が、スパッタ法、真空蒸着法、イオンプレーティング 法又は化学蒸着法のいずれか一つであることを特徴とす る請求項10に記載のポリイミドと導体層の積層体の製 造方法。

【請求項12】 熱可塑性ポリイミドの表面に少なくと も1層の導体層を直接形成する方法が、乾式メッキ法に 熱処理して熱融着せしめた後、さらに湿式メッキ法によ り導体層の総厚みを増加させることを特徴とする請求項 1から9のいずれか一項に記載の製造方法。

【請求項13】 導体層が銅であることを特徴とする請 求項1から12のいずれか一項に記載の製造方法。

【請求項14】 熱可塑性ポリイミドの表面に少なくと も1層の導体層を直接形成して得られるポリイミドと導 体層の積層体であって、該導体層の総厚みが15μmに おける、熱可塑性ポリイミド表面と導体層の密着強度が 5N/cm以上であることを特徴とする積層体。

【請求項15】 板状材料の片面または両面に熱可塑性 ポリイミド有するポリイミド積層体を得た後、該熱可塑 性ポリイミドの表面に熱可塑性ポリイミドの表面に少な くとも1層の導体層を直接形成して得られるポリイミド と導体層の積層体であって、該導体層の総厚みが15 μ mにおける、熱可塑性ポリイミド表面と導体層の密着強 度が5 N/c m以上であることを特徴とする積層体。

【請求項16】 請求項14または15に記載のポリイ ミドと導体層の積層体を用いてなる多層配線板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電気電子回路基板 に用いられるポリイミドと導体層の積層体およびそれを 用いてなる多層配線板、ならびにそれらの製造方法に関 する。

[0002]

【従来の技術】ポリイミドフィルムは優れた耐熱性、絶 縁性、耐溶剤性、および耐低温性等を備えており、コン ビュータ並びにIC制御の電気・電子機器部品材料とし て広く用いられている。近年、コンピュータ並びにIC 制御の電気・電子機器の小型化・薄型化に伴い、配線基 板類やICパッケージ材料も小型化・薄型化が求められ るようになっている。また、電子部品実装基板において も、環境問題から鉛フリーハンダが使用され、それに伴 うハンダ付け温度の上昇に耐えうる基板材料としてポリ イミドフィルムに注目が集まっている。しかしながら、 ポリイミドフィルム上に形成した導体層とポリイミドフ ィルムの密着強度は低く改善が求められている。とのた め、ポリイミドフィルム上にメタライジングを行う場合 には、サンドブラスト処理により機械的に表面を粗化し 導体層とポリイミド組成物の接触面積を増やす方法や、 Cr. Ni, Ti, Co, Vを下地層としてスパッタリ ング法等によりポリイミドフィルム上に導体層を形成す る方法が採られている。しかしながら、サンドブラスト など物理的な粗化ではポリイミド中に充填されたフィラ ー等の突起の除去が完全には出来ず、メタライジング後 の欠陥となる。また、下地金属を用いる方法では、導体 層に電気回路を形成するためのエッチング工程で下地金 属層と導体層のエッチングレートの違いからアンダーカ より少なくとも1層の導体層を直接形成し、加圧及び加 50 ットが入ったりまたは下地金属のエッチング性の悪さか

40

らパターン間のショートを引き起こしやすい上にCr等 を用いた場合にはエッチング廃液処理上の問題も生じ る。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明者ら は、上記の問題点を解決し、ポリイミドと導体層の密着 強度の向上した積層体を得ることに関し、鋭意検討を行 った結果、本発明に到ったのである。即ち本発明が目的 とするところは、ポリイミドの表面に直接形成した導体 層の密着強度を向上である。本発明のポリイミドと導体 10 層の積層体は、サンドブラスト処理による表面粗化や、 Crなどの接着金属層を用いないでも実用十分な密着強 度が得られ、配線板やFPC(フレキシブルプリント配 線基板)に好適な積層体である。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、以下の製造方 法および積層体を提供するものであり、これにより上記 目的を達成できる。

- (1) 熱可塑性ポリイミドの表面に少なくとも1層の 導体層を直接形成し、加熱処理して該ポリイミドの表面 20 に該導体層を熱融着せしめ、熱可塑性ポリイミドと導体 層との密着強度を強化することを特徴とするポリイミド と導体層の積層体の製造方法。
- (2) 板状材料の片面または両面に熱可塑性ポリイミ ドに対応するポリアミド酸を流延または塗布した後、該 ポリアミド酸をイミド化して熱可塑性ポリイミドの表面 を有する積層体を得た後、該熱可塑性ポリイミドの表面 に少なくとも1層の導体層を直接形成して得られる積層 体を、加熱処理して熱融着せしめ熱可塑性ポリイミドと 導体層との密着強度を強化することを特徴とする積層体 の製造方法。
- (3) 熱可塑性ポリイミドのフィルムを板状材料の片 面又は両面に貼り合わせて、熱可塑性ポリイミドの表面 を有するポリイミド積層体を得た後、該熱可塑性ポリイ ミドの表面に少なくとも1層の導体層を直接形成して得 られるポリイミドと導体層の積層体を、加熱処理して熱 融着せしめ熱可塑性ポリイミドと導体層との密着強度を 強化することを特徴とする積層体の製造方法。
- (4) 板状材料が、非熱可塑性ポリイミドフィルムで ある(2)または(3)に記載の積層体の製造方法。
- (5) 導体層の厚さが0.01~5 µmであることを 特徴とする(1)から(4)のいずれか一項に記載の製 造方法。
- (6) 加熱処理温度が50℃以上であることを特徴と する(1)から(5)のいずれか一項に記載のポリイミ ドと導体層の積層体の製造方法。
- (7) 加熱処理温度が熱可塑性ポリイミドのガラス転 移温度より30℃以上高い温度であることを特徴とする (1)から(6)のいずれか一項に記載の製造方法。

を特徴とする(1)から(7)のいずれか一項に記載の 製造方法。

- (9) 加圧時の圧力が、1MPa以上であることを特 徴とする(8)に記載の積層体の製造方法。
- (10) 熱可塑性ポリイミドの表面に少なくとも1層 の導体層を直接形成する方法が乾式メッキ法であること を特徴とする(1)から(9)のいずれか一項に記載の 製造方法。
- (11) 熱可塑性ポリイミドの表面に少なくとも1層 の導体層を直接形成する方法における乾式メッキ法が、 スパッタ法、真空蒸着法、イオンプレーティング法又は 化学蒸着法のいずれか一つであることを特徴とする(1 0) に記載のポリイミドと導体層の積層体の製造方法。
- (12) 熱可塑性ポリイミドの表面に少なくとも1層 の導体層を直接形成する方法が、乾式メッキ法により少 なくとも1層の導体層を直接形成し、加圧及び加熱処理 して熱融着せしめた後、さらに湿式メッキ法により導体 層の総厚みを増加させることを特徴とする(1)から (9)のいずれか一項に記載の製造方法。
- (13) 導体層が銅であることを特徴とする(1)か ら(12)のいずれか一項に記載の製造方法。
 - (14) 熱可塑性ポリイミドの表面に少なくとも1層 の導体層を直接形成して得られるポリイミドと導体層の 積層体であって、該導体層の総厚みが15μmにおけ る、熱可塑性ポリイミド表面と導体層の密着強度が5N /cm以上であることを特徴とする積層体。
 - (15) 板状材料の片面または両面に熱可塑性ポリイ ミド有するポリイミド積層体を得た後、該熱可塑性ポリ イミドの表面に熱可塑性ポリイミドの表面に少なくとも 1層の導体層を直接形成して得られるポリイミドと導体 層の積層体であって、該導体層の総厚みが15μmにお ける、熱可塑性ポリイミド表面と導体層の密着強度が5 N/cm以上であることを特徴とする積層体。
 - (14)または(15)に記載のポリイミド と導体層の積層体を用いてなる多層配線板。 [0005]

【発明の実施の形態】本発明に係るポリイミドと積層体 は、熱可塑性ポリイミドの表面に少なくとも1層の導体 層を直接形成して得られるポリイミドと導体層の積層体 を、加圧及び加熱処理して熱融着せしめ熱可塑性ポリイ ミドと導体層との密着強度を強化することにより得られ る。また、板状材料の片面または両面に熱可塑性ポリイ ミド層が形成された積層体であれば更に好ましい。前記 板状材料としては、非熱可塑性ポリイミドフィルム、あ るいは予め回路を形成した回路基板、あるいはCu、F e、Ni等の金属の1種以上を主として含む金属板など が挙げられるが、これらの中でも、非熱可塑性ポリイミ ドフィルムであることが得られる積層体を軽量化できう る点及びロール ツウ ロールで加工できる点で好まし (8) 加熱処理して熱融着せしめる際に加圧すること 50 い。導体層を直接形成するポリイミドは特に限定されな

いが、後の熱融着を目的とする加熱処理のためには非熱 可塑性ポリイミドの表面を有するものが好ましく、非熱 可塑性ポリイミドフィルムの片面または両面に熱可塑性 ボリイミド層が形成された積層体であれば更に好まし * *い。ここで言う熱可塑性ポリイミドとしては、下記一般 式(1)

[0006]

[化1]

【0007】(式中、kは1以上の正数、m, nはポリ 10%す。)で表されるポリアミド酸を脱水閉環して得られる マー鎖中の各反復モル分率に等しく、mは約0.00~ 約0.95の範囲であり、nは約1.00~約0.05 の範囲である。但しmとnとの合計は1.00に等し い。A、Bは4価の有機基、Xは2価の有機基を示

熱可塑性ポリイミドが好ましく、一般式(1)中のA及 びBが下記群(1)

[8000]

【化2】

【0009】に示す4価の有機基から選択される少なく [0010] とも2種であることがより好ましい。さらに、前記一般 [化3] 式(1)中のX及びYが下記群(2)

【0011】に示す2価の有機基の群から選択される少 なくとも1種であれば特に好ましい。これらの、熱可塑 性ポリイミドを板状材料、特には非熱可塑性ポリイミド フィルムの表面上に形成する方法は、代表的には、板状 材料、特には非熱可塑性ポリイミドフィルムの片面また は両面に一般式(1)で示したようなポリアミド酸を流 延または塗布した後、該ポリアミド酸を熱的方法または 化学的方法でイミド化して熱可塑性ポリイミドの表面を 有するポリイミド積層体を得る方法が挙げられるが、溶 剤可溶性の熱可塑性ポリイミドであれば溶液を塗布後乾 燥する等によっても得ることが出来る。また、当然、こ の熱可塑性ポリイミドを非熱可塑性ポリイミドフィルム 表面に形成せずに、これ自体を単層フィルムとして用い ても良い。このポリイミドの表面にスパッタリング法、 蒸着法、EB蒸着法、CVD法、イオンプレーティング 法等公知の乾式メッキ法により導体層を形成することが 50 気中で行っても良く、また、導体層の酸化を避ける目的

できる。特に、スパッタ法、真空蒸着法、イオンプレー ティング法、化学蒸着法を用いることが好ましい。この とき乾式メッキ法のみで導体層形成を行っても良いが、 乾式メッキ法により第1の導体層を0.01μmから5 μmの厚さに形成した後、さらに第2第3の導体層を乾 式メッキや電解メッキ又は無電解メッキなどの湿式メッ キにより第1の導体層と併せて1~18μmの厚さに積 層して堆積させることもできる。第1の導体層にはC r, Ni, Ti, V, Co, Pt, Au等の金属単体や 合金が用いることも出来るが、導体層をエッチングによ り再加工する場合の加工性及び廃エッチング液の処理の 問題からCuで構成されることが望ましい。

【0012】ポリイミドと導体層の密着強度を向上させ る加熱処理は第1の導体層形成後に行っても良く、又第 2の導体層形成後に行っても良い。さらに加熱処理は大



(6)

20

でAr, N₂, He等の不活性気体中で加熱処理を行っ たり真空オーブン中で加熱処理を行っても良い。加圧及 び加熱処理は乾式メッキによる導体層形成後に行うこと が望ましい。加熱処理温度は特に規定されるものではな いが例えば大気中30分程度の加熱処理を行う場合に は、50℃より高い温度で行うと加熱処理の効果が大き いので望ましく、さらに望ましくは100℃以上が望ま しい。加熱処理の最高温度は加熱処理による銅層の酸化 が許容できる範囲で有れば良く、例えば大気中の加熱処 理で処理時間30分で有れば300℃以下、望ましくは 10 250℃以下が望ましい。さらに加圧及び加熱処理は1 MPa以上、好ましくは2MPa以上の圧力で行うこと が望ましい。加熱温度は、熱可塑性ポリイミドのガラス 転移温度温度以上であると熱融着の効果が得られるため 望ましく、さらにガラス転移温度温度より30℃以上高 い温度がより望ましい。加圧及び加熱処理は導体層の酸 化を避ける目的でAr, N, He等の不活性気体中で 加圧及び加熱処理を行ったり真空プレス装置を用いて加 圧加熱処理を行っても良い。加圧及び加熱処理の最高温 度は加圧及び加熱処理による熱可塑性ポリイミド樹脂の 流れ量が許容できる範囲で有れば良く、例えば加圧及び 加熱処理を3MPaの圧力で処理時間10分の条件で行 うので有ればガラス転移温度温度より130℃高い温度 以下、望ましくはガラス転移温度温度より100℃高い 温度以下が望ましい。すなわち、加圧及び加熱処理の温 度は、例えばガラス転移温度150℃のポリイミドを用 いた場合150℃から280℃が望ましく、さらに18 0℃から250℃がより望ましい。このように加圧及び 加熱処理を行った後、さらに電解メッキまたは無電解メ ッキにより3μm~35μmの厚さまで導体層の総厚み を厚くすることが出来る。このようにして導体層の総厚 みを暑くすることにより得られた積層体の密着強度は、 該導体層の総厚みが15μmにおける、ポリイミドと表 面と導体層の密着強度が5N/cm以上となっているも のが好ましい。ここで、絵厚みが15μmにおける、ポ リイミドと表面と導体層の密着強度とは、導体層の幅3 mmにおいてポリイミドに対して90度方向に50mm /minの剥離速度で剥離を行った場合の密着強度をい

9

【0013】電解メッキまたは無電解メッキに先立ち、 加圧及び加熱処理を行った導体層表面を次亜塩素酸ナト リウム、亜塩素酸カリウム、過塩素酸カリウム等の次亜 塩素酸イオン、亜塩素酸イオン、過塩素酸イオンを生じ る化合物のうち1種以上を用いた水溶液で表面処理を行 うことが望ましい。以上のように本発明によればポリイ ミドフィルム表面にサンドブラスト法による表面粗化 や、乾式メッキにおけるCr. Ni等の下地金属層を用 いることなく、導体層とポリイミドの密着強度の優れた 積層体を得ることが出来る。さらに密着強度を強める目 的で導体層形成前のポリイミドの表面を物理的に粗化し

う。

たり、不活性ガス中のプラズマ処理でポリイミドの表面 を粗化又は/及び官能基の導入を行ったり、接着金属層 を用いることは本発明の効果を妨げるものではない。 [0014]

10

【実施例】以下に実施例により本発明をより具体的に説 明するが、本発明はこれら実施例によって限定されるも のではない。本実施例中熱可塑性ポリイミドのガラス転 移温度DMA法に従って、DMS2000(日本電子工 業)を用いて、動的粘弾性データよりガラス転移点を算 出した。

(実施例1)系全体を氷水で冷やし、窒素置換を行った 2000m1の密口セパラブルフラスコに39.9gの 1, 2-ビス(2-(4-アミノフェノキシ)エトキ シ] エタン (以下、DA3EGという) を596.2g のジメチルホルムアミド (以下、DMFという) を用い て投入し15分間撹拌した。次に73.9gの2,2' ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕プロバ ン (以下、BAPPという)を100gのDMFを用い て投入しさらに15分間撹拌した。続いて82.1gの 3, 3'4, 4'-エチレングリコールジベンゾエート テトラカルボン酸二無水物(以下、TMEGという)を 20gのDMFを用いて投入し、続いて29gの3, 3′4、4′-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水 物(以下、BTDAという)を20gのDMFを用いて 投入し30分間撹拌した。撹拌の後さらに4.1gのT MEGを36.9gのDMFに溶かした溶液をフラスコ 内の粘度に注意しながら徐々に投入し、その後1時間撹 拌しながら放置し、ポリアミド酸溶液を得た。とのポリ アミド酸溶液を100g測り取り、11,37gの無水 酢酸と11.18gのイソキノリンと11.95gのD MFからなるケミカルキュア剤を加えて、遠心脱泡を行 った後PETフィルム上に流延塗布し、80℃で25分 間加熱し、PETフィルムを引き剥がした後150℃及 び200℃で各25分間加熱イミド化を行い、厚さ25 μmの熱可塑性ポリイミドフィルムを得た。この様にし て得られた熱可塑性フィルムを(株)島津製作所製マグ ネトロンスパッタ装置HSM-720の基板ホルダーに それぞれ取り付け4×10-1Paまで排気した。その後 Arガスを流してマグネトロンスパッタ装置内を0.6 40 Paの圧力に保った。この状態で銅ターゲットを用い、 電流値0.5AでDC電源を用いてフイルム上に銅薄膜 を0.1μm形成した。尚、薄膜形成前にプレスパッタ を15分間行った。との様にして熱可塑性フィルム上に 銅薄膜を形成したサンプル3枚用意した。次にこれらの サンプルを12cm×8cmの大きさに切り出し、電解 メッキ法により2Aの電流を流しながら導体厚みが20 μπになるまで電解銅メッキを行った。このサンプルを 4日間室温下で放置したのち30分間の加熱処理を行っ た。加熱処理温度は、サンプルにより変化させそれぞれ 50 100°Cであるもの、140°Cであるもの、200°Cで

あるものを用意した。その後導体表面に形成された銅酸 化膜を5 w t %硫酸溶液で除去し3 m m幅のサーキット テープを貼り付け、塩化第二鉄溶液でエッチングを行 い、サーキットテープを除去後50℃30分間の乾燥を 行って3mm幅のパターンを得たのち、3mm幅パター ンのビール強度測定を行い密着強度を求めた。ビール強 度の測定に当たり剥離方向を90度として、引張速度を 50 mm/分の条件で行った。ビール強度の値は3回測 定を行い平均値を採用した。測定結果を表1に示す。

[0015]

【表1】

	加熱処理温度 (℃)	ピール強度 (N/cm)
実施例1	100	4, 1
	140	4. 3
	200	4. 4
比較例1	なし	1. 0

【0016】(実施例2)系全体を氷水で冷やし、窒素 置換を行った2000mlの三口セバラブルフラスコに 20 した。続いて82.1gのTMEGを20gのDMFを 123. 1gのBAPPを716. 2gのDMFを用い て投入し15分間撹拌した。続いて33.8gのBTD Aを20gのDMFを用いて投入した。続いて76.0 gのTMEGを20gのDMFを用いて投入し30分間 撹拌した。30分間の撹拌の後、さらに4.1gのTM EGを36.9gのDMFに溶かした溶液をフラスコ内 の溶液の粘度に注意しながら徐々に投入し、その後1時 間撹拌しながら放置し、ポリアミド酸溶液を得た。一方 で、ピロメリット酸二無水物/p-フェニレン(トリメ リット酸モノエステル酸無水物) /p -フェニレンジア ミン/4,4 '-ジアミノジフェニルエーテルをモル比 で5/5/4/6の割合で合成したポリアミド酸の17 wt%DMF溶液を遠心分離による脱泡後、最終厚みが 17μmとなるようにアルミ箔上に流延塗布した。この アルミ箔とポリアミド酸溶液の積層体を110℃で4分 間加熱し自己支持性を有するゲルフィルムを得た。との ゲルフィルムを上記で調合した熱可塑性ポリイミドの前 駆体であるポリアミド酸溶液に浸漬し、熱可塑性ポリイ ミド層の最終片面厚みが4μmとなるように余分なポリ アミド酸を除去した後、150℃、200℃、250 ℃、300℃、350℃で各1分間加熱して、トータル 厚み25μmのボンディングシートを得た。このボンデ ィングシートを用い、実施例1の方法と同様にしてサン プル作成を行った。但し室温下4日間放置後の熱処理温 度は170℃のものと220℃のものの2種類作成し た。その後実施例1と同様に3mm幅ピール強度測定用 パターンを形成しピール強度を測定した。測定結果を表 2に示す。

[0017]

【表2】

	加熱処理温度 (℃)	ピール強度 (N/cm)
実施例2	170	4, 2
	220	4. 4
比較例2	なし	1, 8

【0018】(比較例1)実施例1と同様のフィルムを 用い、室温下4日間放置後の熱処理を行わない以外は、 実施例1と同様にしてサンブルを作成しビール強度を測 10 定した。測定結果を表1に示す。

(比較例2) 実施例2と同様にボンディングシートを用 い、室温下4日間放置後の熱処理を行わない以外は、実 施例1と同様にしてサンブルを作成しビール強度を測定 した。測定結果を表2に示す。

【0019】(実施例3)系全体を氷水で冷やし、窒素 置換を行った2000mlの密口セパラブルフラスコに 39.9gのDA3EGを596.2gのDMFを用い て投入し15分間撹拌した。次に73.9gのBAPP を100gのDMFを用いて投入しさらに15分間撹拌 用いて投入し、続いて29gのBTDAを20gのDM Fを用いて投入し30分間撹拌した。撹拌の後さらに 4. lgのTMEGを36. 9gのDMFに溶かした溶 液をフラスコ内の粘度に注意しながら徐々に投入し、そ の後1時間撹拌しながら放置し、ポリアミド酸溶液を得 た。このボリアミド酸溶液を100g測り取り、11, 37gの無水酢酸と11.18gのイソキノリンと1 1. 95gのDMFからなるケミカルキュア剤を加え て、遠心脱泡を行った後PETフィルム上に流延塗布 し、80℃で25分間加熱し、PETフィルムを引き剥 がした後150℃及び200℃で各25分間加熱イミド 化を行い、厚さ25μmの熱可塑性ポリイミドフィルム を得た。このポリイミドフィルムのガラス転移温度を測 定したところ150℃であった。この様にして得られた 熱可塑性フィルムを(株)島津製作所製マグネトロンス パッタ装置HSM-720の基板ホルダーにそれぞれ取 り付け4×10-1Paまで排気した。その後Arガスを 流してマグネトロンスパッタ装置内を0.6 Paの圧力 に保った。この状態で銅ターゲットを用い、電流値0. 40 5AでDC電源を用いてフイルム上に銅薄膜を0.3 µ m形成した。尚、薄膜形成前にプレスパッタを15分間 行った。この様にして熱可塑性フィルム上に銅薄膜を形 成したサンブルを6枚用意した。次にこれらのサンブル を12cm×8cmの大きさに切り出し、厚さ0.2m mのフッ素樹脂フィルムシート(日東電工(株)製ニフ トロン)を用いてサンブルの両面を覆い、さらに両面を 厚さ5mmのゴムシート及び、フェロ板を用いて両面を 覆った。プレス装置を用い3MPaと時間を10分にし てプレス温度を100℃であるもの、150℃であるも 50 の、180℃であるもの、200℃であるもの、250

℃であるもの、300℃であるものを用意した。これら のサンプルを5%硫酸水溶液で30秒間表面洗浄を行っ た後、次に電解メッキ法により2Aの電流を流しながら 導体厚み 15 μmになるまで電解銅メッキを行った。 C のサンプルを4日間室温下で放置したのち、3mm幅の サーキットテープを貼り付け、塩化第二鉄溶液でエッチ ングを行い、サーキットテープを除去後50℃30分間 の乾燥を行って3mm幅のパターンを得たのち、3mm 幅パターンのピール強度測定を行い密着強度を求めた。 ピール強度の測定に当たり剥離方向を90度として、引 10 °Cで各1分間加熱して、トータル厚み25μmのボンデ 張速度を50mm/分の条件で行った。ピール強度の値 は3回測定を行い平均値を採用した。なお、ピール強度 の測定は、島津製作所(株)製、オートグラフS-10 0-Cにて測定した。測定結果を表3に示す。

[0020]

【表3】

	加圧及び加熱処 理温度 (で)	ピール強度 (N/cm)
実施例3	100	4. 1
	150	1, 5
	180	5. 2
	200	5, 6
	250	5. 3
:	300	4. 4
比較例3	なし	1. 2
比較例4	加圧なし15 OC	3. 0

【0021】(実施例4)系全体を氷水で冷やし、窒素 置換を行った2000m1の三口セパラブルフラスコに 123. 1gのBAPPを716. 2gのDMFを用い て投入し15分間撹拌した。続いて33.8gのBTD Aを20gのDMFを用いて投入した。続いて76.0 gのTMEGを20gのDMFを用いて投入し30分間 撹拌した。30分間の撹拌の後、さらに4.1gのTM EGを36.9gのDMFに溶かした溶液をフラスコ内 の溶液の粘度に注意しながら徐々に投入し、その後1時 間撹拌しながら放置し、ポリアミド酸溶液(A)を得 た。このポリアミド酸溶液の一部を乾燥及びイミド化し て得られた熱可塑性ポリイミドのガラス転移温度は19 0°Cであった。一方で、ピロメリット酸二無水物/p-フェニレン(トリメリット酸モノエステル酸無水物)/ p-フェニレンジアミン/4, 4 '-ジアミノジフェニ ルエーテルをモル比で5/5/4/6の割合で合成した

ポリアミド酸(B)の17wt%DMF溶液を遠心分離 による脱泡後、最終厚みが17μmとなるようにアルミ 箔上に流延塗布した。このアルミ箔とポリアミド酸溶液 の積層体を110℃で4分間加熱し自己支持性を有する ゲルフィルムを得た。とのゲルフィルムを上記で調合し た熱可塑性ポリイミドの前駆体であるポリアミド酸溶液 (A) に浸漬し、熱可塑性ポリイミド層の最終片面厚み が4μmとなるように余分なポリアミド酸を除去した 後、150℃、200℃、250℃、300℃、350 ィングシートを得た。このボンディングシートを用い、 実施例3の方法と同様にしてサンブル作成を行った。但 し加圧及び加熱処理の圧力及び時間は実施例と同一の条 件ながら加熱温度は150°Cであるもの、220°Cであ るもの、250℃であるものの3種類作成した。その後 実施例3と同様に3mm幅ピール強度測定用パターンを 形成しビール強度を測定した。測定結果を表4に示す。 [0022]

【表4】

加熟処理温度 ピール強度 (C) (N/cm) 実施例4 150 1. 9 220 5.0 250 5.6 比較例5 なし 1.8

【0023】(比較例3)実施例3と同様のフィルムを 用い、加圧及び加熱処理を行わない以外は、実施例3と 同様にしてサンプルを作成しビール強度を測定した。測 定結果を表3に示す。

(比較例4) 実施例3と同様のフィルムを用い、スパッ タ金属膜を形成後オープン中で加圧を行うことなしに1 50℃10分保持した以外は、実施例3と同様にしてサ ンプルを作成しビール強度を測定した。測定結果を表3 に示す。

(比較例5) 実施例4と同様にボンディングシートを用 い、加圧及び加熱処理を行わない以外は、実施例3と同 様にしてサンブルを作成しビール強度を測定した。測定 結果を表4に示す。

[0024]

【発明の効果】本発明のポリイミドと導体層の積層体 は、サンドブラスト処理による表面粗化や、Cェなどの 接着金属層を用いないでも実用十分な密着強度が得ら れ、配線板やFPCに好適な積層体である。

20

フロントページの続き

(51)Int.C7.'

識別記号

H 0 5 K 3/46

(72)発明者 西中 賢

滋賀県大津市比叡辻2-1-2-143

FΙ

テーマコード (参考)

H 0 5 K 3/46

G

Fターム(参考) 4F100 AB17B AB17C AK49A AK49D

AROOB AROOC ATOOD BA02 BA03 BA04 BA05 BA06 BA07 BA10A BA10B BA10C BA10D BA13 EC032 EH461 EH712 EJ081 EJ202 EJ422 GB43 JA20B JA20C JB16A JB16E

JG01B JG01C JK06 YY00

YY00B YY00C

5E343 AA02 AA18 BB14 BB24 BB71

DD22 DD32 DD43 EE36 ER33

CG02 CG11

5E346 AA05 AA06 AA12 AA15 AA22

AA32 AA51 CC10 CC32 DD15

DD22 DD24 DD32 DD44 EE06

EE18 GG17 GG18 GG22 GG27

CG28 HH11